

Содержание

● Электронные и оптические свойства полупроводников

Ромака В.А., Стадник Ю.В., Аксельруд Л.Г., Ромака В.В., Fruchart D., Rogl P., Давыдов В.Н., Гореленко Ю.К.

Механизм локальной аморфизации сильно легированного интерметаллического полупроводника $Ti_{1-x}V_xCoSb$. . . 769

Соболев В.В., Калугин А.И., Соболев В.Вал., Исхакова С.Г.

Фундаментальные спектры оптических функций ферроэлектрика нитрита натрия 777

● Полупроводниковые структуры, границы раздела и поверхность

Мездрогина М.М., Криволапчук В.В., Феоктистов Н.А., Даниловский Э.Ю., Кузьмин Р.В., Разумов С.В., Кукушкин С.А., Осипов А.В.

Спектры фотолюминесценции гетероструктур $n-ZnO/p-GaN(Er + Zn)$ и $p-AlGaN(Er + Zn)$ 782

Вирт И.С., Курило И.В., Рудый И.А., Сизов Ф.Ф., Михайлов Н.Н., Смирнов Р.Н.

$CdTe$ как пассивирующий слой в гетероструктуре $CdTe/HgCdTe$ 788

Арсентьев И.Н., Бобыль А.В., Тарасов И.С., Болтовец Н.С., Иванов В.Н., Беляев А.Е., Камалов А.Б., Конакова Р.В., Кудрик Я.Я., Литвин О.С., Миленин В.В., Руссу Е.В.

Свойства барьерных контактов к InP_x наноразмерными слоями TiV_x 793

Востоков Н.В., Шашкин В.И.

Адмитанс и нелинейная емкость многослойной структуры металл-полупроводник 799

● Низкоразмерные системы

Сизов В.С., Цацульников А.Ф., Лундин В.В.

Нановключения $InGaN$ в матрице $AlGaN$ 804

Кукушкин В.А.

Периодическое создание кратковременной инверсии населенностей на межподзонных лазерных переходах в квантовых ямах 810

Гниденко А.А., Заводинский В.Г.

Влияние кислорода на структуру и электронные свойства нанокластеров кремния Si_n ($n = 5, 6, 10, 18$) 817

Мамутин В.В., Егоров А.Ю., Крыжановская Н.В., Михрин В.С., Надточий А.М., Пирогов Е.В.

Методы управления длиной волны излучения в гетероструктурах $InAs/GaAsN/InGaAsN$ на подложках $GaAs$. . 823

Зайцев С.В., Бричкин А.С., Дорожкин П.С., Bacher G.
Релаксация экситонов в полумагнитных асимметричных двойных квантовых ямах 831

Алешкин В.Я., Гавриленко В.И., Иконников А.В., Криштопенко С.С., Садофьев Ю.Г., Спирин К.Е.

Обменное усиление g -фактора в гетероструктурах $InAs/AlSb$ 846

● Физика полупроводниковых приборов

Özden S., Bayhan H., Döpmöz A., Bayhan M.

Measurement and comparison of silicon $p-i-n$ -photodiodes ac impedance at different voltages 852

Алещенко Ю.А., Жуков А.Е., Капаев В.В., Капаев Ю.В., Копьев П.С., Устинов В.М.

Управление заселенностью верхней рабочей подзоны электрическим полем в структурах с асимметричными барьерами для униполярного лазера 856

Слободян Т.Е., Булашевич К.А., Карпов С.Ю.

Оптическое ограничение в лазерных диодах на основе нитридов III группы. I. Теория, оптические свойства материалов 864

Слободян Т.Е., Булашевич К.А., Карпов С.Ю.

Оптическое ограничение в лазерных диодах на основе нитридов III группы. II. Анализ гетероструктур на различных подложках 871

Иванов П.А., Грехов И.В., Потапов А.С., Самсонова Т.П.

Импульсный пробой диодов Шоттки на основе $4H-SiC$ с охраняемым $p-n$ -переходом, изготовленным имплантацией бора 878

Мурашова А.В., Винокуров Д.А., Пихтин Н.А., Слипченко С.О., Шамахов В.В., Васильева В.В., Капитонов В.А., Лешко А.Ю., Лютецкий А.В., Налет Т.А., Николаев Д.Н., Станкевич А.Л., Фетисова Н.В., Тарасов И.С., Kim Y.S., Kang D.H., Lee C.Y.

Мощные лазерные диоды с длиной волны излучения 835 нм на основе различных типов лазерных гетероструктур . . 882

● Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур

Бачериков Ю.Ю., Конакова Р.В., Миленин В.В., Охрименко О.Б., Светличный А.М., Поляков В.В.

Изменение характеристик оксидных пленок гадолиния, титана и эрбия на поверхности $n-6H-SiC$ под воздействием сверхвысокочастотной обработки 888

Покотило Ю.М., Петух А.Н., Дзичковский О.А.

Кинетика формирования различных типов водородсодержащих доноров в кремнии, имплантированном протонами . 893